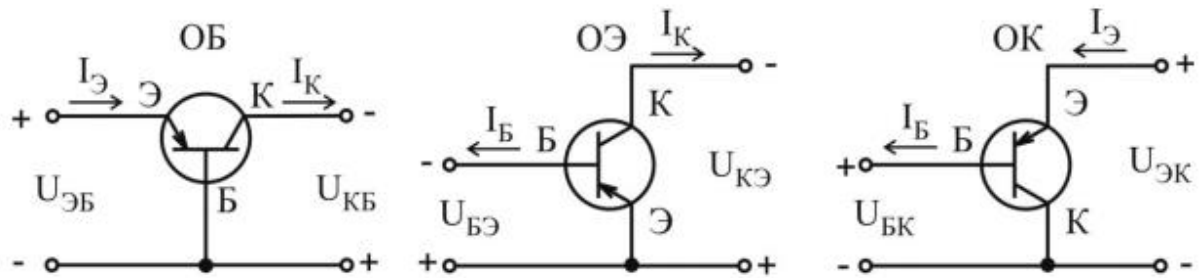


Эммитер - режим инжекция заряда в базу.

Коллектор - для экстракции инжектированных нос. заряда в базу.



Активный режим: Э(открыт)-К(закрыт)

Инверсный режим: Э(закрыт)-К(открыт)

Режим отсечки: Э,К(закрыты)

Режим насыщения: Э,К(открыты)

КФ инжекции: (эффективность эмиттерного перехода)

Внутр. уравнение транзистора: Ток $\mathcal{E} = T.К + T.Б$

Статические ВАХ отражают зависимости входными и выходными токами и напряжениями транзистора.

К|Т|3|15|А

К - Кремний, Германий

Т - Т(биполярный), П(полевой)

3 - частота|мощность(таблица)

15 - номер разработки

А - группа

Обозначения частоты и мощности транзисторов

Частота	Мощность		
	Малая	Средняя	Большая
Низкая	1	4	7
Средняя	2	5	8
Высокая	3	6	9

Основные параметры биполярных транзисторов:

Максимально допустимый постоянный ток коллектора;

Максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер;

Максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю;

Максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю;

Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю;

Максимально допустимая постоянная мощность, рассеиваемая на коллекторе;

Статический коэффициент передачи тока;

Напряжение насыщения между коллектором и эмиттером;

Обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера;

Обратный ток эмиттера. Ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора;

Граничная частота коэффициента передачи тока;

Коэффициент шума;

Емкость коллекторного перехода;

Максимально допустимая температура перехода.